



概述

TX6212B 是一款内置 100V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。

采用固定关断时间的控制方式，关断时间可通过外部电容进行调节，工作频率可根据用户要求而改变。

通过调节外置的电流采样电阻，能控制高亮度LED灯的驱动电流，使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加PWM信号，还可以进行LED灯调光。

内部集成了 VDD 稳压管，软启动以及过温保护电路，减少外围元件 并提高系统可靠性。

采用 ESOP8 封装。散热片 内置接 SW 脚。

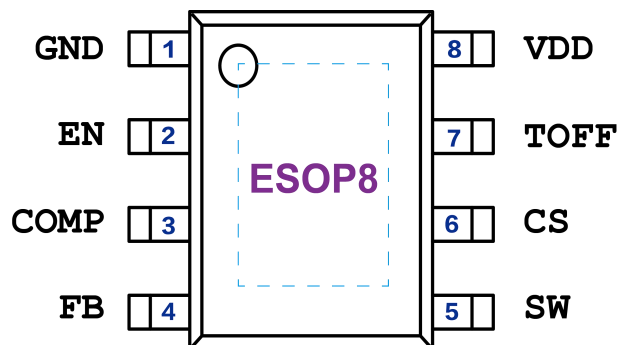
产品特点

- 输入电压：2.6-100V
- 输出电流：高达 2A
- 转换效率：高达 95%
- 最高工作频率：高达1MHz
- 关断时间可调
- 智能过温保护
- 内置 VDD 稳压管
- 软启动

应用领域

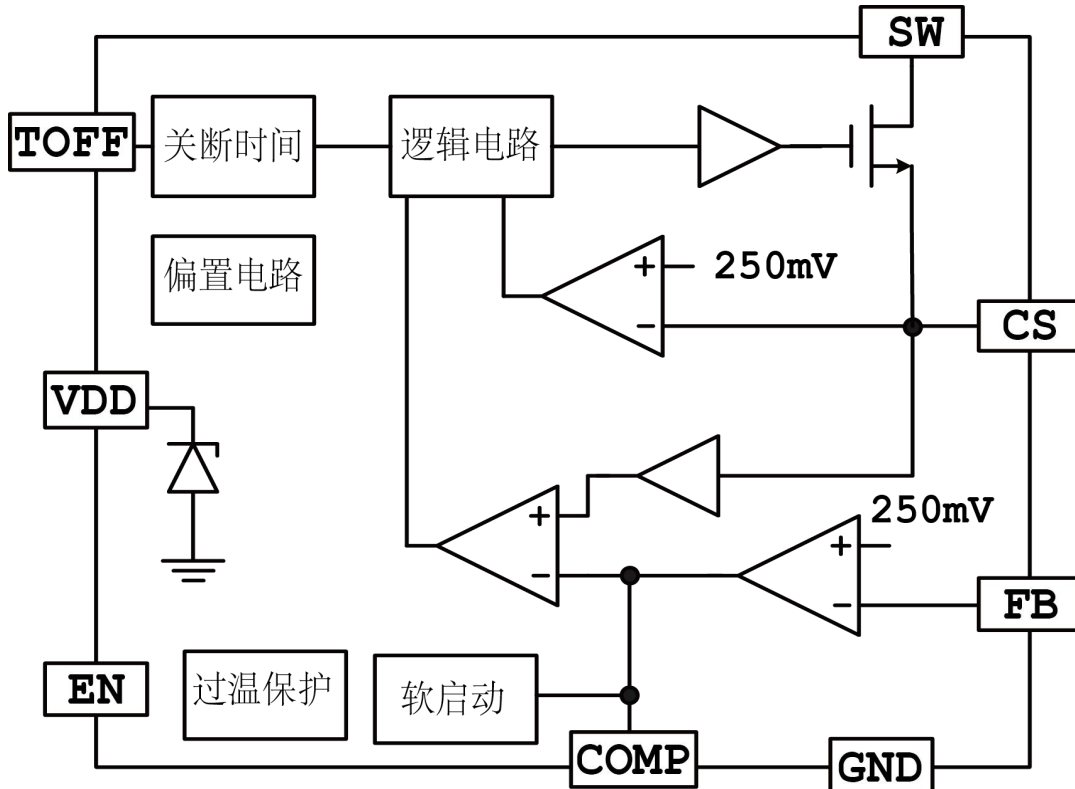
- 网络系统
- 医疗设备
- 消费类电子产品
- LED 灯杯
- 电池供电的 LED 灯串
- 平板显示 LED 背光
- 大功率 LED 照明

管脚定义

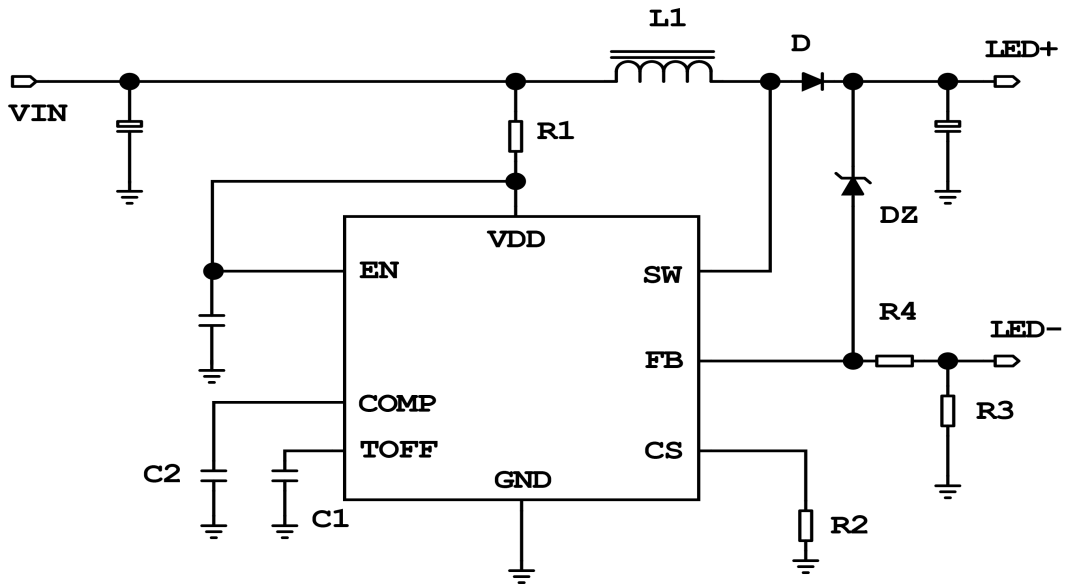


管脚功能描述

管脚号	字符	管脚描述
1	GND	接地
2	EN	芯片使能，高电平有效，可做PWM调光
3	COMP	频率补偿
4	FB	输出电流反馈
5	SW	功率MOS管漏极
6	CS	输入限流检测脚
7	TOFF	关断时间设置
8	VDD	电源输入
9	EP	散热器，内接SW端

电路框图


原理图



极限应用参数

参数名称	标号	测试调件	MIN	TYP	MAX	Unit
电源电压	VDD		-	-	5.5	V
SW端最大电压	VSW				100	V
EN/COMP/FB/CS /TOFF 端电压	V_MAX		-0.3	VDD+0.3		V
ESOP8最大功耗	P_ESOP8		-	-	0.8	W
工作温度	TA		-20		85	°C
存储温度	T_STG	-	-40	-	120	°C
焊接温度	T_SD	焊接, 10秒左右	230	-	240	°C
静电耐压	V_ESD				2000	V

注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。



电气特性 测试条件: VDD=5.5V, TA=25°C, 除非另有说明

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD 钳位电压	VDD	I_VDD<10mA		5.5		V
欠压保护电压	V_UVLO	VDD上升		2.6		V
欠压保护迟滞	V_HYS			0.4		V
工作电流	I_OP	F_OP=200KHz		1.3		mA
待机电流	I_INQ	无负载, EN为低电平		200		uA
过流保护阈值	VCS_TH		240	250	260	mV
FB脚电压	VFB		240	250	260	mV
最小关断时间	TOFF_MIX	TOFF 脚无外接电容		620		ns
EN端高电平	H_EN		0.4*VDD			V
EN端低电平	L_EN				0.8	V
MOS耐压	VDS		100			V
MOS管导通内阻	RDSON	VGS=5V		120		mΩ
过温调节	OTP_TH			135		°C

应用指南

TX6212B 是一款内置 100V 功率 NMOS 升压型大功率 LED 恒流驱动 IC，采用固定关断时间的峰值电流模式控制方式。芯片内部由误差放大器、PWM 比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间控制电路、PWM 逻辑、功率管驱动、基准等电路单元组成。芯片通过 FB 管脚来采样 LED 输出电流。系统处于稳态时 FB 管脚电压 V_{FB} 恒定在约 250mV。当 V_{FB} 电压低于 250mV 时，误差放大器的输出电压即 COMP 管脚电压升高，从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流增大，因此增大了输入功率， V_{FB} 电压将会升高。反之，当 V_{FB} 电压高过 250mV 时，误差放大器的输出电压会逐渐降低，从而使得在功率管导通期间电感的峰值电流减小，因此减小了输入功率， V_{FB} 电压随之降低。芯片通过 CS 管脚采样电感电流，实现峰值电流控制。此外 CS 脚还用来限制最大输入电流，实现过流保护功能。系统关断时间可通过连接到 TOFF 管脚的电容 C1 来设置。通过设定关断时间，可设置系统的工作频率。COMP 管脚是误差放大器的输出端，需在 COMP 脚外接电阻、电容来实现频率补偿。芯片内部集成了 VDD 稳压管，以及软启动和过温保护电路。

LED 电流设置

LED 输出电流由连接到 FB 管脚的反馈电阻 R3 设定：

$$I_{LED} = \frac{0.25}{R3}$$

TOFF 关断时间设置

关断时间可由连接到 TOFF 引脚端的电容 C1 设定：其中 $T_D = 61\text{ns}$ 。如果不外接 C1，芯片内部将关断时间设定为 620ns。对于大多数应用，建议 C1 电容取值为 22~33pF 或更大。

$$T_{OFF} = 0.51 * 150 \text{ K}\Omega * (C_{OFF} + 7.3 \text{ pF}) + T_D$$

系统工作频率 F_S

系统工作频率 F_S 由下式确定：其中 V_{IN} 、 V_{OUT} 分别是系统输入和输出电压。

$$F_S = \frac{V_{IN}}{V_{OUT} * T_{OFF}}$$

电感取值

流过电感的纹波电流大小与电感取值有关。工作于连续模式时电感纹波电流由下式确定：

$$\Delta I_L = \frac{V_{OUT} - V_{IN}}{L} * T_{OFF}$$

增大电感值纹波电流会减小，反之增大。连续模式下电感的峰值电流由下式确

$$I_{pk} = \frac{V_{OUT} * I_{LED}}{V_{IN} * \eta} + \frac{1}{2} \Delta I_L$$

电感电流工作在连续模式与非连续模式的临界值由下式确定：

$$I_{Cri} = \frac{V_{IN} * (V_{OUT} - V_{IN}) * T_{OFF}}{2 V_{OUT} * I_{LED}}$$

电感数值大于 L_{cri} 则系统工作在连续模式，电感数值小于 L_{cri} 则系统工作在非连续模式。在电感选择时，应保证流过电感的峰值电流不引起电感的磁饱和。通常要求电感的饱和电流大于电感峰值电流的 1.5 倍以上。同时应选择低 ESR 的功率电感，在大电流条件下电感自身的 ESR 会显著影响系统的转换效率。

Rcs设置

需合理设置 R2 电阻阻值，以防止在正常负载下因为输入限流而限制输出功率。

$$R2 \leq \frac{0.2}{\frac{V_{OUT} * I_{LED}}{\eta * V_{IN}} + \frac{(V_{OUT} - V_{IN}) * V_{IN}}{2L * F_S * V_{OUT}}}$$

其中 η 表示转换效率，典型地可取 90%。应在最低输入电压下计算得到 R2 值。系统的最大峰值电流 I_{PK} 由电阻 R2 限定：

$$I_{PK} \leq \frac{0.25}{R2}$$

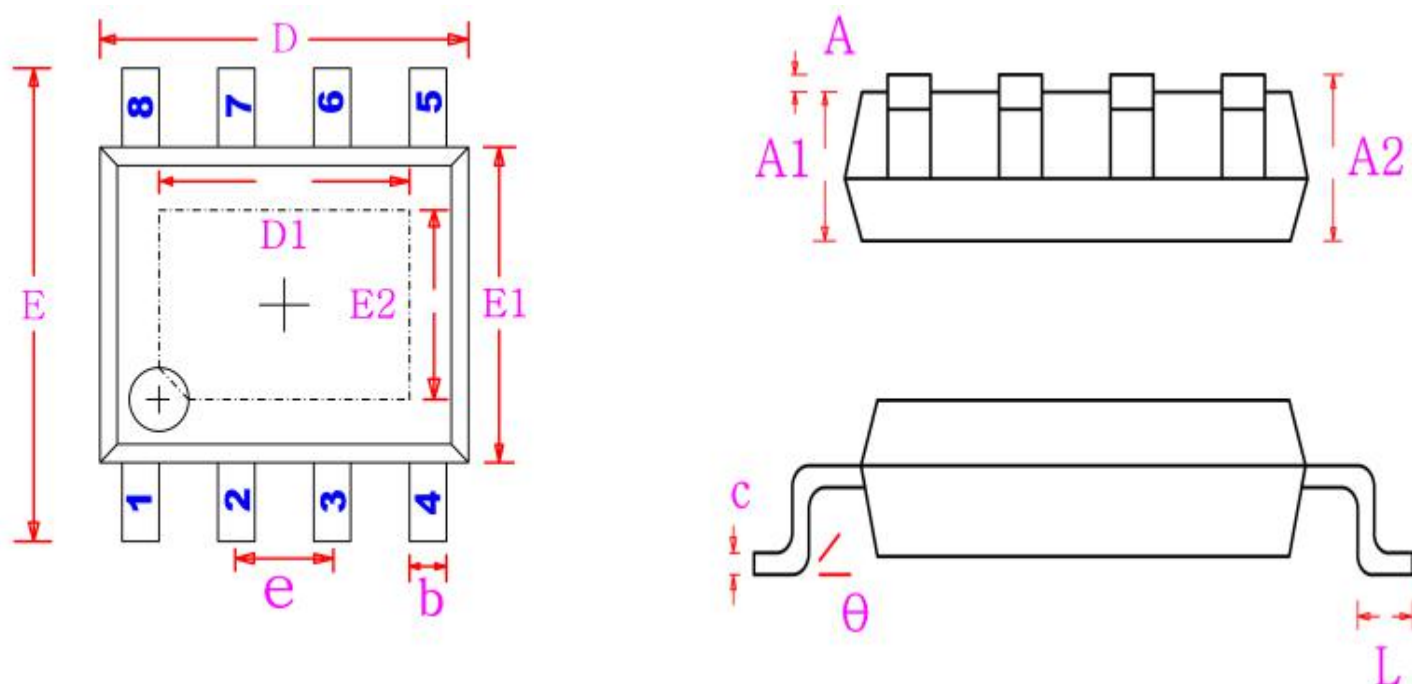
供电电阻的选择

芯片通过供电电阻 R1 对芯片 VDD 供电。其中 VDD 取 5.5V， I_{VDD} 典型值取 2mA， V_{IN} 为输入电压。当开关频率设置的较高时，芯片工作电流会增大。相应地应减小供电电阻取值。芯片内部接 VDD 脚的稳压管最大钳位电流不超过 10mA。应注意 R1 的取值不能过小，以免流入 VDD 的电流超过允许值，否则需外接稳压管钳位。

$$R1 = \frac{V_{IN} - V_{DD}}{I_{VDD}}$$

过温保护

当芯片温度过高时，系统会限制输入电流峰值，典型情况下当芯片内部温度超过 135°C 以上时，过温调节开始起作用：随温度升高输入峰值电流逐渐减小，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

封装信息 ESOP8


字符	公制		英制	
	最小	最大	最小	最大
D	4.7	5.1	0.185	0.2
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	5.8	6.2	0.228	0.244
E1	3.8	4	0.15	0.157
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.27		0.05	
b	0.33	0.51	0.013	0.02
A	0.05	0.25	0.004	0.01
A1	1.35	1.55	0.053	0.061
A2	1.35	1.75	0.053	0.069
L	0.4	1.27	0.016	0.050
c	0.17	0.25	0.006	0.01
θ	0°	8°	0°	8°